

PULSED LASER DIODES

LASER COMPONENTS, CANADA INC.

Tel +1 450 455 8270 : lcc@laser-components.com

Lasers 905 nm

Specifications (@ 21°C, 150 ns, 6.66kHz)						
part number	wavelength	min power	package	emitting area	Iop	Ith
	nm	Watt		µm x µm	A	mA
905D1S1.5X	905	3	U,S	37.5 x 1	3,5	100
905D1S03X	905	6	U,S	75 x 1	7	200
905D1S06X	905	13	U,S	150 x 1	15	400
905D1S09X	905	19	U,S	230 x 1	22	600
905D1S12X	905	26	U,S	300 x 1	30	800
905D1S16X	905	34	U,S	400 x 1	40	1200
905D2S06X	905	25	U,S	150 x 125	15	400
905D3S09X	905	55	U,S	230 x 225	22	600
905D3S12X	905	70	U,S	300 x 225	30	800
905D4S12X	905	90	U,S	300 x 340	30	800
905D4S16X	905	130	U,S	400 x 340	40	1200

Option: C, R, Y package

Generic characteristics at 21°C				
	min	typ.	max	units
wavelength	895	905	915	nm
spectral bandwidth		5		nm
temperature coefficient		0.27		nm/°C
beam spread				
parallel to junction plane		12		degrees
perpendicular				
single element		25		degrees
stacks		30		degrees
reverse voltage			6	V
pulse duration				
single element			1	µs
stacks			200	ns
duty factor			0,1	%
temperature				
storage	-55		100	°C
operating	-45		85	°C

905nm Multi-junction devices

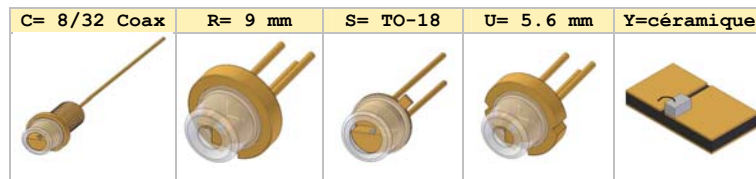
New

Specifications (@ 21°C, 150 ns, 3,33 kHz)						
part number	wavelength	min power	package	emitting area	Iop	Ith
	nm	Watt		µm x µm	A	mA
905D1S2J03X	905	15	U,S	80 x 5	8	310
905D1S2J09X	905	40	U,S	230 x 5	22	1050
905D1S3J03X	905	25	U,S	85 x 10	11	300
905D1S3J06X	905	50	U,S	160 x 10	22	500
905D1S3J09X	905	75	U,S	235 x 10	30	800
905D1S3J08X*	905	70	U,S	200 x 10	30	750
905D2S3J08X*	905	140	U,S	200 x 125	30	750
905D3S3J08X*	905	210	U,S	200 x 250	30	750

Option: C, R, Y package

* (specifications @ 21°C, 100 ns, 1 kHz)

Generic characteristics at 21°C				
	min	Typ.	max	units
wavelength	895	905	915	nm
spectral bandwidth		8		nm
temperature coefficient		0.28		nm/°C
beam spread				
parallel to junction plane		13		degrees
perpendicular		20		degrees
reverse voltage			6	V
pulse duration				
single element			150	ns
stacks			100	ns
duty factor			0.1	%
temperature				
storage	-55		100	°C
operating	-45		85	°C



DIODES LASERS PULSÉES

COMPOSANTES LASER, CANADA INC.
Tel +1 450 455 8270 : lcc@laser-components.com



Lasers 905 nm

Spécifications (à 21°C, 150 ns, 6.66kHz)						
Numéro de pièce	Longueur d'onde	Puissance min.	Boîtier	Zone émettrice	Iop	Ith
	nm	Watt		µm x µm	A	mA
905D1S1.5X	905	3	U,S	37.5 x 1	3,5	100
905D1S03X	905	6	U,S	75 x 1	7	200
905D1S06X	905	13	U,S	150 x 1	15	400
905D1S09X	905	19	U,S	230 x 1	22	600
905D1S12X	905	26	U,S	300 x 1	30	800
905D1S16X	905	34	U,S	400 x 1	40	1200
905D2S06X	905	25	U,S	150 x 125	15	400
905D3S09X	905	55	U,S	230 x 225	22	600
905D3S12X	905	70	U,S	300 x 225	30	800
905D4S12X	905	90	U,S	300 x 340	30	800
905D4S16X	905	130	U,S	400 x 340	40	1200

Option: boîtier C, R, Y

Caractéristiques génériques à 21°C				
	min	Typ.	max	unités
Longueur d'onde	895	905	915	nm
Largeur spectrale		5		nm
Coefficient température		0.27		nm/°C
Propagation du faisceau				
Plan \parallel à celui de la jonction		12		degrés
Plan \perp à celui de la jonction				
Diode laser simple		25		degrés
Empilement		30		degrés
Tension inverse			6	V
Durée d'impulsion				
Diode laser simple			1	µs
Empilement			200	ns
Facteur d'utilisation			0,1	%
température				
Entreposage	-55		100	°C
Opération	-45		85	°C

Lasers 905 nm à jonctions multiples

NOUVEAU

Spécifications préliminaires (à 21°C, 150 ns, 3,33 kHz)						
Numéro de pièce	Longueur d'onde	Puissance (typique)	Boîtier	Zone émettrice	Iop	Ith
	nm	Watt		µm x µm	A	mA
905D1S2J03X	905	15	U,S	80 x 5	8	310
905D1S2J09X	905	40	U,S	230 x 5	22	1050
905D1S3J03X	905	25	U,S	85 x 10	11	300
905D1S3J06X	905	50	U,S	160 x 10	22	500
905D1S3J09X	905	75	U,S	235 x 10	30	800
905D1S3J08X*	905	70	U,S	200 x 10	30	750
905D2S3J08X*	905	140	U,S	200 x 125	30	750
905D3S3J08X*	905	210	U,S	200 x 250	30	750

Option: boîtier C, R, Y

* (spécifications @ 21°C, 100 ns, 1 kHz)

Caractéristiques génériques à 21°C				
	min	Typ.	max	unités
Longueur d'onde	895	905	915	nm
Largeur spectrale		8		nm
Coefficient température		0.28		nm/°C
Propagation du faisceau				
Plan \parallel à celui de la jonction		13		degrés
Plan \perp à celui de la jonction		20		degrés
Tension inverse			6	V
Durée d'impulsion				
Diode laser simple			150	ns
Empilement			100	ns
Facteur d'utilisation			0.1	%
température				
Entreposage	-55		100	°C
Opération	-45		85	°C

